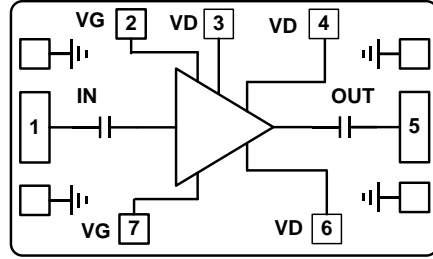




主要特点

工作频率: 2 - 6 GHz
 增益: 29dB@+5V, 28.5dB@+6V
 P1dB: 30 dBm@+5 V, 31 dBm@+6 V
 Psat: 31.2 dBm@+5 V, 32.5 dBm@+6 V
 PAE@Psat: 32%@+5V, 30%@+6V
 静态工作电流: 820 mA@+5 V
 880 mA@+6 V
 芯片尺寸: 2.5 × 2.0 × 0.1 mm³

功能框图

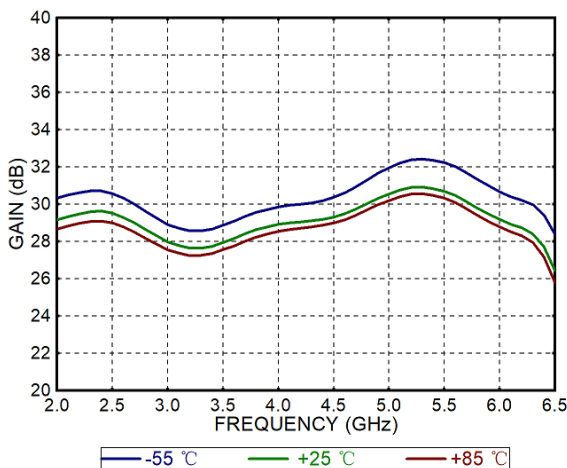


性能指标 ($T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$, $V_{DD} = +5/+6\text{ V}$, $V_G = -0.6\text{ V}^*$, $I_{DD} = 820/880\text{ mA}^*$)

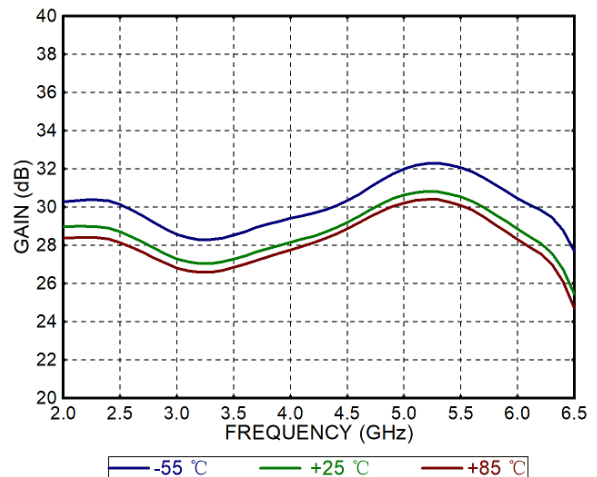
参数	VDD=+5V			VDD=+6V			单位
	最小	典型	最大	最小	典型	最大	
工作频率	2-6			2-6			GHz
增益		29			28.5		dB
增益平坦度		±2			±2		dB
输入回波损耗		13			13		dB
输出回波损耗		12			12		dB
输出功率 1dB 压缩点		30			31		dBm
饱和功率		31.2			32.5		dBm
PAE@Psat		32			30		%
OIP3		41			40.5		dBm
静态电流	700	820	940	760	880	1000	mA

*备注: 可以通过调整 VG 电压来控制工作电流在典型值附近, VG 调节范围: -1.2V ~ -0.2V。

增益VS 温度 @VD=+5V

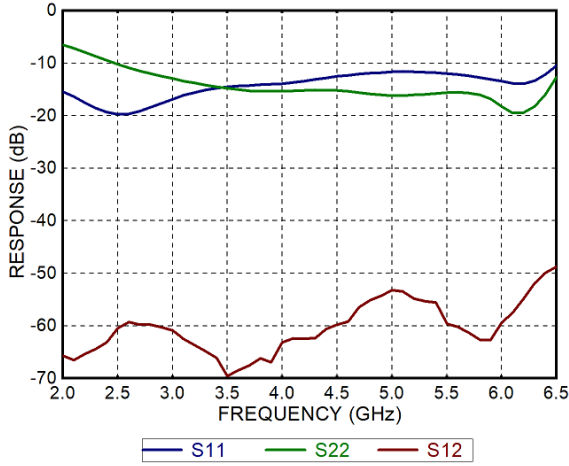


增益VS 温度 @VD=+6V

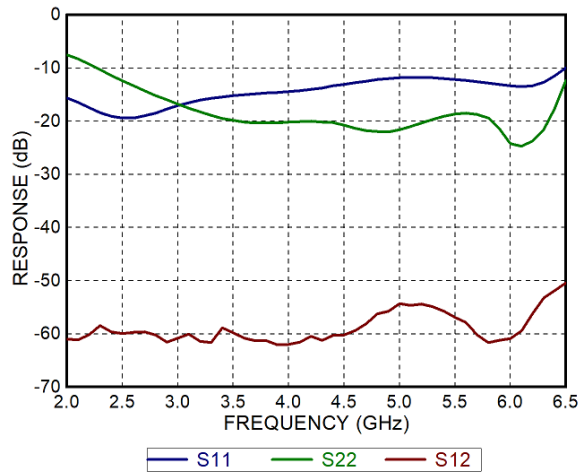




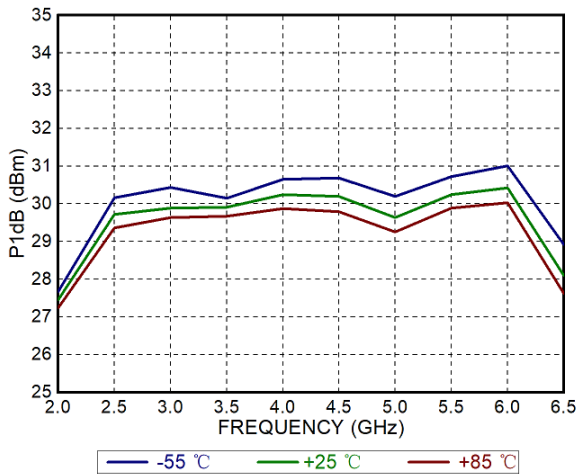
回波损耗&反向隔离度 @VD=+5V



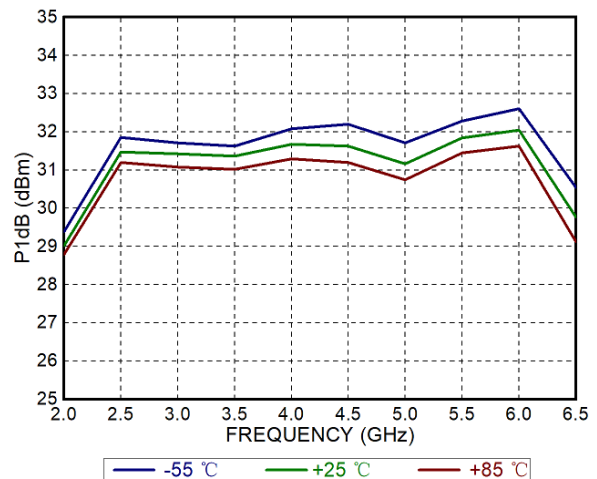
回波损耗&反向隔离度 @VD=+6V



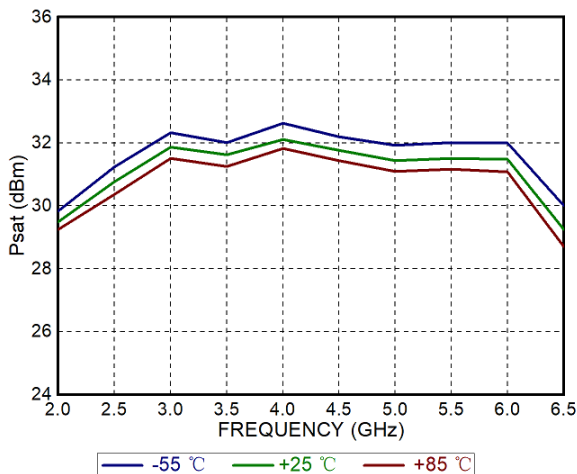
输出功率P₁ VS 温度 @VD=+5V



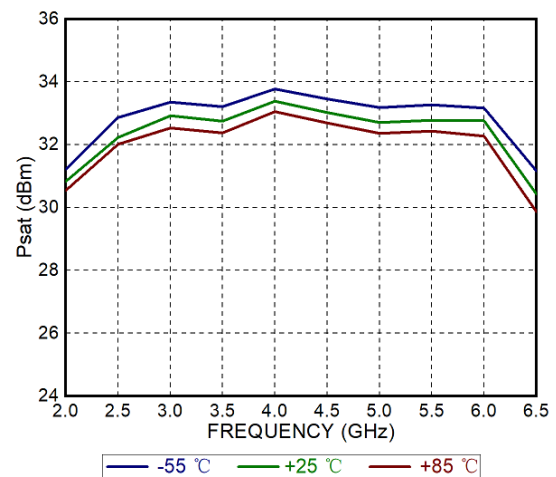
输出功率P₁ VS 温度 @VD=+6V



输出功率 VS 温度 @VD=+5V

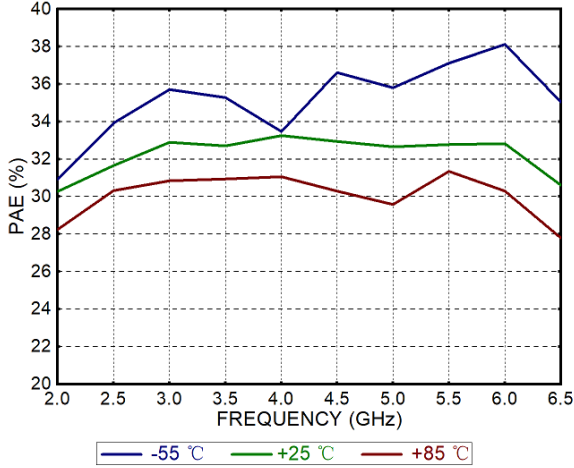


输出功率 VS 温度 @VD=+6V

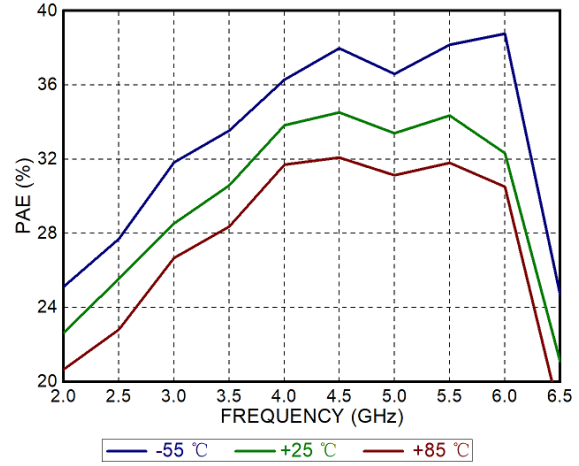




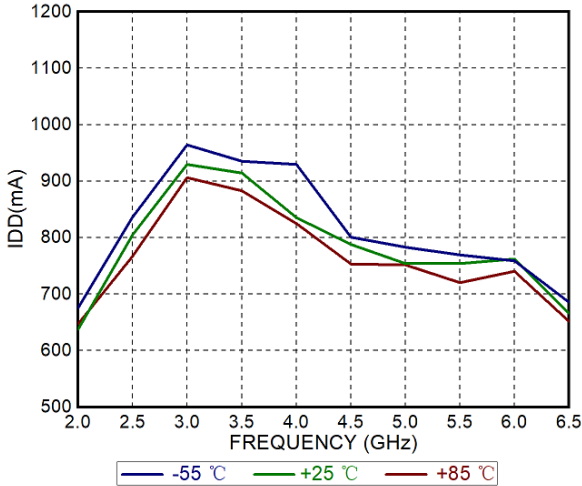
PAE@Psat VS 温度 @VD=+5V



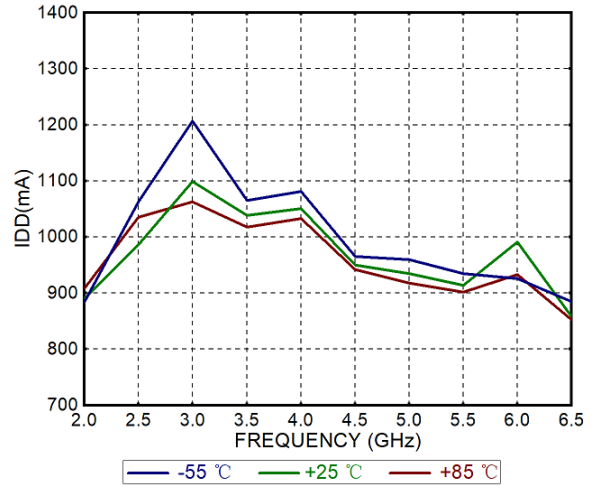
PAE@Psat VS 温度 @VD=+6V



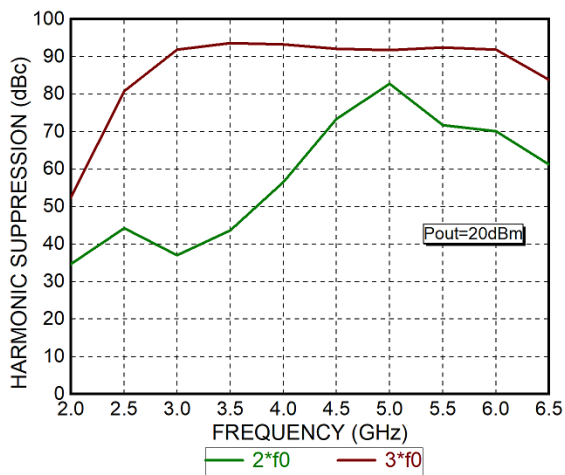
动态电流@Psat @VD=+5V



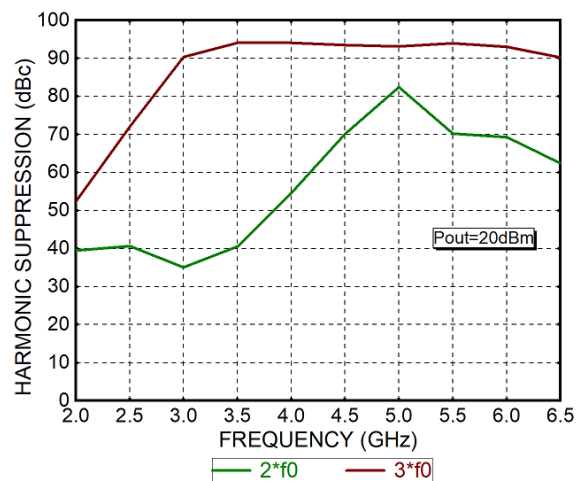
动态电流@Psat @VD=+6V



谐波抑制 @VD=+5V

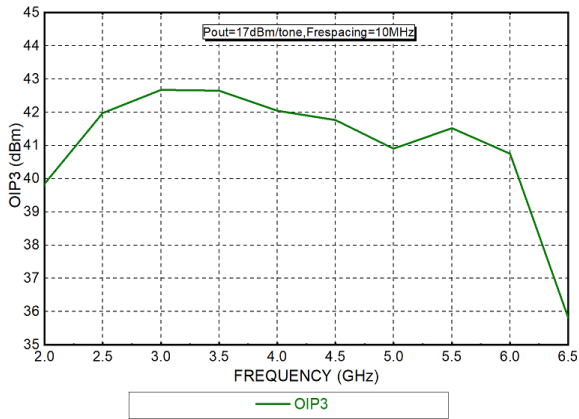


谐波抑制 @VD=+6V

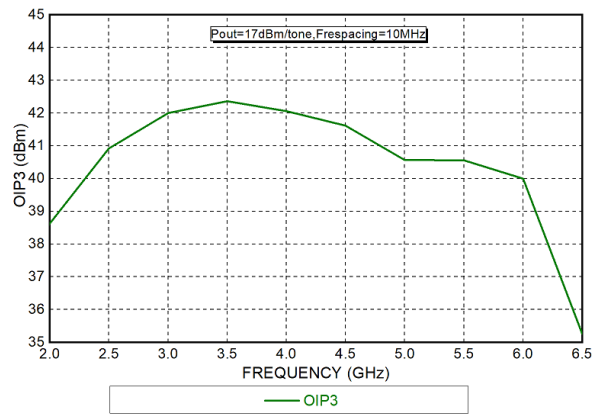




OIP3 @VD=+5V

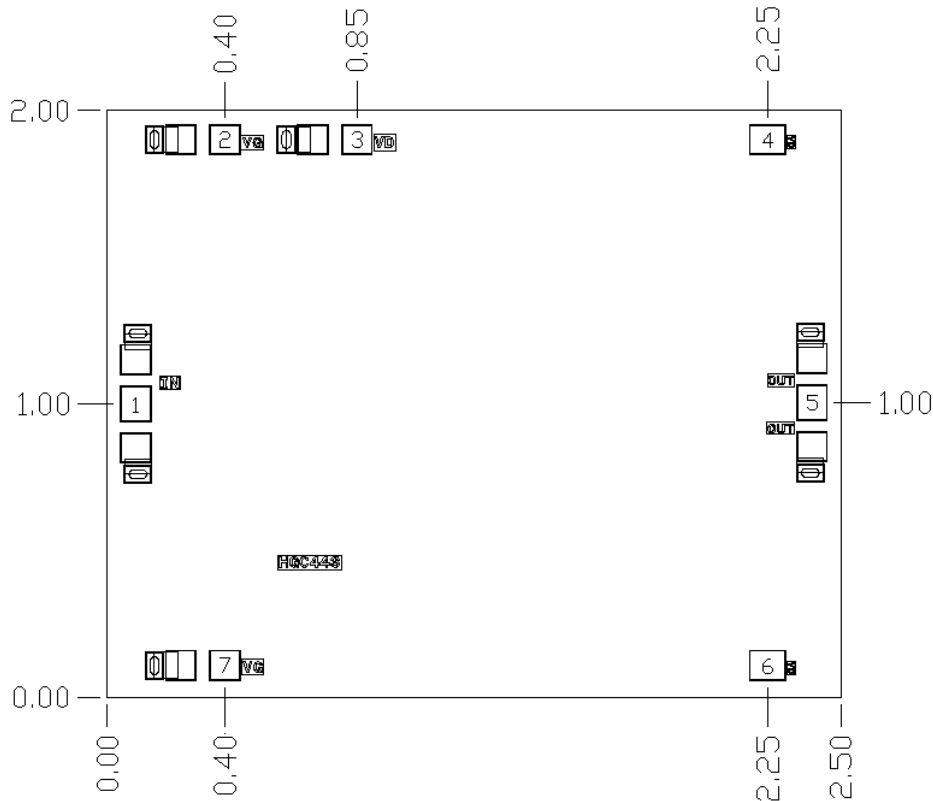


OIP3 @VD=+6V



物理参数

单位: mm

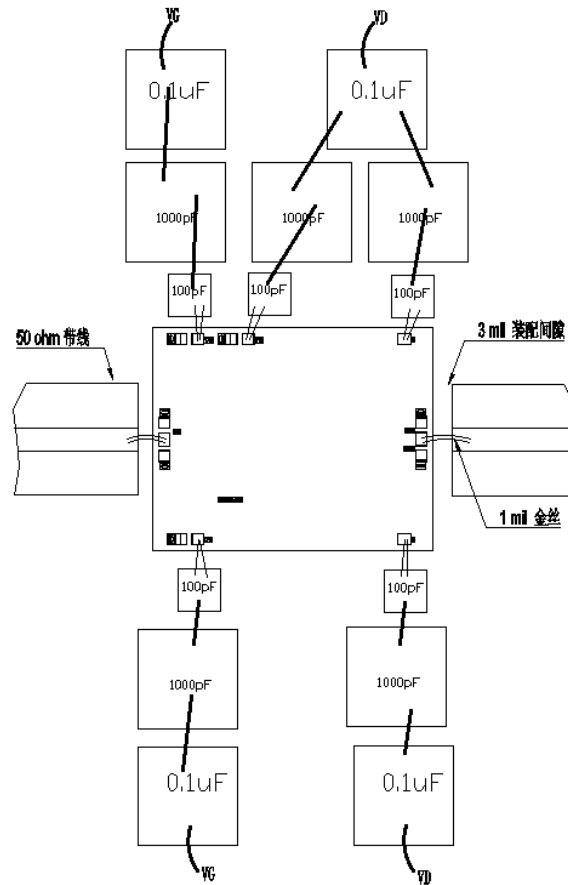




焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是射频信号输入端口, AC 耦合, 内部集成隔直电容, 匹配至 50 Ohm
2、7	VG	该焊盘是栅极电源电压输入端口, 推荐工作范围-1.2V~-0.2V
3、4、6	VD	该焊盘是漏极电源电压输入端口
5	OUT	该焊盘是射频信号输端口, AC 耦合, 内部集成隔直电容, 匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

推荐装配图



注: 电源去耦应尽可能充分, 实际应用中 最外围去耦电容可以适当增大。



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 μm
3. 键合焊盘金属化：金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 需要共晶烧结装配
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN，厚度 0.15 μm ，属于氢敏感器件，注意氢防护

极限参数

1. 电源电压：+6.5 V
2. 射频输入功率：+18 dBm
3. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$